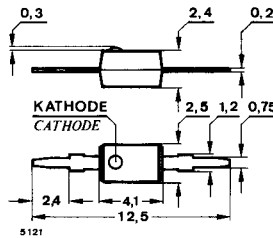


Silizium-Epitaxial-Planar-Diode Silicon epitaxial planar diode

Anwendungen: Bereichsumschaltung in VHF-Tunern

Applications: Band selector in VHF-tuners

Abmessungen in mm
Dimensions in mm



Kunststoffgehäuse
Plastic Case
SOD 23
Gewicht · Weight
max. 0,1 g

Absolute Grenzdaten Absolute maximum ratings

Sperrspannung Reverse voltage	U_R	35	V
Durchlaßstrom Forward current	I_F	100	mA
Sperrschichttemperatur Junction temperature	t_j	100	°C
Lagerungstemperaturbereich Storage temperature range	t_{stg}	-55...+100	°C

Wärmewiderstand Thermal resistance

		Min.	Typ.	Max.
Sperrschicht-Umgebung Junction ambient $l = 4 \text{ mm}, t_L = \text{konstant}$ constant	R_{thJA}			400 °C/W

BA 182

Kenngrößen Characteristics

Min. Typ. Max.

$t_j = 25^\circ\text{C}$, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

Durchlaßspannung
Forward voltage

$I_F = 100\text{ mA}$

$U_F^{(1)}$

1,2

V

Sperrstrom
Reverse current

$U_R = 20\text{ V}$

$U_R = 20\text{ V}, t_j = 60^\circ\text{C}$

I_R

100

nA

I_R

1

μA

Durchbruchspannung
Breakdown voltage

$I_R = 10\ \mu\text{A}$

$U_{(BR)}$

35

V

Diodenkapazität
Diode capacitance

$f = \text{MHz}, U_R = 1\text{ V}$

$U_R = 20\text{ V}$

C_D

2,1

pF

C_D

0,8

1,25

pF

Differentieller Durchlaßwiderstand
Differential forward resistance

$I_F = 5\text{ mA}, f = 200\text{ MHz}$

r_f

0,5

0,7

Ω

